



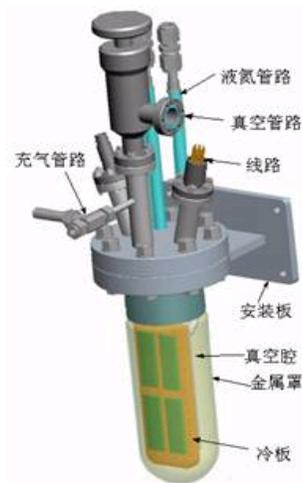
新闻动态

- ▷ 图片新闻
- ▷ 头条新闻
- ▷ 综合新闻
- ▷ 学术活动
- ▷ 科研动态
- ▷ 通知公告
- ▷ 业内信息
- ▷ 合作交流

现在位置：[首页](#) > [新闻动态](#) > [科研动态](#)

中科院微电子所在低温复杂环境总剂量效应研究领域取得重要进展

2011-06-17 | 编辑：一室 曾传滨 刘刚 | [【大】](#) [【中】](#) [【小】](#) [【打印】](#) [【关闭】](#)



日前，通过近两年的努力，国内第一个低温可充气真空辐射系统由中科院微电子所硅器件与集成技术研究室(一室)研制成功。

该低温测试系统由一室可靠性测试小组的刘刚、毕津顺、曾传滨等科研人员自行设计完成，其极限真空 $<10^{-7}$ Pa，12小时静态漏气 <0.1 Pa，气体充气能力为1Pa—1MPa，液氮温度连续实验时间 >5 小时。

通过该测试系统，研究人员首次测到电子元器件在液氮低温环境下总剂量效应的实验数据和封装气体环境对电子元器件总剂量效应的实验数据，实验数据表明电子元器件在低温辐射总剂量效应影响比室温辐射影响要恶劣数倍，即使经室温退火后总剂量效应的影响仍然非常严重。该低温测试平台将为微电子所的相关电子元器件低温环境下总剂量效应的机理研究提供可靠和稳定的低温测试支撑平台。

附件下载:

相关新闻:

[北京集成电路测试技术联合实验室正式启动](#)

[中科院EDA中心1053个管脚FCBGA封装顺利通过测试](#)

[微电子所研制成功国内领先水平的单通道超高速ADC芯片](#)



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号